

グローバル COE 定例セミナー
「パワー半導体デバイスの基礎」
セミナーレポート

日時：2007年12月14日 17:20-18:20

場所：大阪大学工学部 電気系 E5-312

概要：

本ユニットのアドバイザーでもある岩本 英雄 様（三菱電機(株) 中部支社半導体デバイス部）に講師をお願いし、パワー半導体デバイスの基礎についてご講演いただいた。

パワー半導体デバイスの主要な性能である耐圧などの特性が、どのようにデバイス構造によって決定されるのかなどの基礎的な知識から、MOSFET や IGBT など個別の素子の特性改善のための工夫、そして本ユニットのテーマであるワイドバンドギャップ素子に関する展望などの内容について、幅広く、学生からも理解できるようご講演いただいた。

参加者からは、Si デバイスにおける技術的課題や、最近発表された高耐圧の GaN 素子に関する質問がでされ、非常に有意義な議論の時間をもつことができた。



以上